THOMSON-CSF

general purpose and switching diode selector guide

guide de sélection
diodes de commutation et usage général

Case	DO 7					CB 127				
$I_{F(AV)}$ / $V_{R(V)}$	50...90 mA			100...150 mA			200...225 mA		400 mA	
10			[redacted]							
25	1N 456		[redacted]			[redacted]	1N 456 A			
30						[redacted]				
35			[redacted]							
40					BAY 41					
50			[redacted]	BAY 44		[redacted]				
60	1N 457				BAY 42		1N 457 A			
70							1N 483 B		BAW 21A (3)	
75			[redacted]			[redacted]				
80					BAY 43					
90									BAW 21 B (3)	BAX 12 (3)
100				BAY 73				BAY 72 BAV 19		
125				1N 458 A 1N 3595 (2)						
130				1N 484			1N 484 A			
150				BAY 45				BAX 16 BAV 20		
175					1N 3070					
200					SFD 49			BAX 17 BAV 21		
240					BA 224-300					
300				BAY 46						

1N 456 $t_{rr} \geqslant 300$ ns

BAX 12 t_{rr} = 15...120 ns

[redacted] $t_{rr} \leqslant 6$ ns

(1) : Ultra fast diode $t_{rr} \leqslant 0{,}75$ ns $C \leqslant 0{,}8$ pF
Diode ultra rapide $t_{rr} \leqslant 0{,}75$ ns $C \leqslant 0{,}8$ pF

(2) : Very low leakage diode $I_R < 1$ nA @ V_R = 125 V
Diode à faible courant de fuite

(3) : Controlled avalanche diode. DO 35 case (CB-102)
Diode à avalanche controlée. DO 35 boîtier (CB-102)

(4) : DO 34 case (CB-104)
DO 34 boîtier (CB-104)

silicon signal diodes
diodes de signal au silicium

THOMSON-CSF

general purpose — T_{amb} = 25°C — usage général

Type	V_R-V_{RM} max (V)	I_O max (mA)	V_F max (V)	/ I_F (mA)	I_R max (nA)	/ V_R (V)	C §typ max (pF)	Case
1N 456	25	90	1	40	25	25	10	
1N 456 A	25- 30	200	1	100	25	25		
1N 457	60	75	1	20	25	60	8	
1N 457 A	60- 70	200	1	100	25	60		
1N 461	25- 60	60	1	15	500	25	10	
1N 461 A	25- 30	200	1	100	500	25		
1N 462	60- 70	50	1	5	500	60	§ 8	
1N 462 A	60- 70	100	1	100	500	60		
1N 483 B	70- 80	200	1	100	25	60		
1N 484	130-150	100	1,1	100	250	125		
1N 484 A	130-150	200	1	100	25	125		
1N 484 B	130-150	200	1	100	25	125		
BAY 17	15	200	1	100	100	12	§ 1,2	
BAY 18	60	200	1	100	100	50	§ 1,2	
BAY 19	120	200	1	100	100	100	§ 1,2	
BAY 20	180	200	1	100	100	150	§ 1,2	DO 7* (CB-26)
BAY 21	300	200	1	100	100	300	§ 1,2	
BAY 44	50- 50	250	1,1	100	200	50	§ 7	
BAY 72	100-125	225	1	100	100	100	5	
BAY 73	100-125	150	1	200	5	100	8	
SFD 180	50- 60	80	1,15	30	100	50	§ 4	
SFD 181	150-150	80	1,15	30	100	150	§ 4	
BAV 17	25	200	1	100	100	20	5	
BAV 18	60	200	1	100	100	50	5	
MC 19	150	100	0,9	30	100	150	§10	
MC 51	300	100	0,9	30	100	300	§10	

* Available on request in CB-127 case. Designation : 1N...DHD or BA...DHD.
** Livrable sur demande en boîtier CB-127. Appellation commerciale : 1N...DHD ou BA...DHD.*

very low capacitance - general purpose — T_{amb} = 25°C — très faible capacité - usage général

Type	V_{RM} max (V)	I_O max (mA)	V_F max (V)	/ I_F (mA)	I_R max (nA)	/ V_R (V)	I_R / V_R T_{amb}125°C max (µA)	(V)	C / V_R max (pF)	(V)	Case
12 P 2	200	60	1	10	500	200	100	200	0,4	2	
13 P 2	200	40	1	1	500	200	100	200	0,4	2	
14 P 2	150	40	1	1	500	150	100	150	0,4	2	
15 P 2	100	40	1	1	500	100	100	100	0,4	2	
16 P 2	50	40	1	1	500	50	100	50	0,4	2	
17 P 2	30	40	1	1	500	30	100	30	0,4	2	
18 P 2	10	40	1	1	500	10	100	10	0,4	2	
19 P 2	10	60	1	10	500	10	100	10	0,4	2	
23 J 2	200	60	1	10	100	200	20	200	0,4	2	
24 J 2	150	60	1	10	100	150	20	150	0,4	2	
25 J 2	100	60	1	10	100	100	20	100	0,4	2	
26 J 2	50	60	1	10	100	50	20	50	0,4	2	
27 J 2	30	60	1	10	100	30	20	30	0,4	2	
28 J 2	10	60	1	10	100	10	20	10	0,4	2	DO 7 (CB-26)
BAW 32 A	200	60	1,3	60	100	200	20	200	0,4	2	
23 J2 C	200	60	1	10	100	200	20	200	0,4	2	
BAW 32 B	150	60	1,3	60	100	150	20	150	0,4	2	
24 J2 C	150	60	1	10	100	150	20	150	0,4	2	
BAW 32 C	100	60	1,3	60	100	100	20	100	0,4	2	
25 J2 C	100	60	1	10	100	100	20	100	0,4	2	
BAW 32 D	50	60	1,3	60	100	50	20	50	0,4	2	
26 J2 C	50	60	1	10	100	50	20	50	0,4	2	
BAW 32 E	10	60	1,3	60	100	10	20	10	0,4	2	
28 J2 C	10	60	1	10	100	10	20	10	0,4	2	